

a) $E_F = ?$

$$E_F = \frac{(3\pi^2 N)^{2/3} (\hbar)^2}{2m^*} = \frac{(3 \cdot 11^2 \cdot 8 \cdot 10^{28})^{2/3} \left(\frac{6,62}{2\pi} \cdot 10^{-34}\right)^2}{2 \cdot (9,1 \cdot 10^{-31})} = 1,08 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

$$E_F = \frac{1,08 \cdot 10^{-18}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 6,7 \text{ eV}$$

b)

$$\frac{1}{2} m v_F^2 = E_C = E_F \Rightarrow v_F = \sqrt{\frac{2 \cdot E_F}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,08 \cdot 10^{-18}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 1,5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

c) $J = \sigma \cdot E$; $\sigma = \frac{e^2 N_s \tau}{m^*} \Rightarrow J = \sigma E \Rightarrow E = \frac{J}{\sigma}$

$$v_x = \frac{e E \tau}{m^*} = \frac{e J \tau}{m^* \sigma} = \frac{e \cdot I \tau}{m^* A} \cdot \frac{m^*}{e^2 N_s \tau} \Rightarrow v_x = \frac{I}{NeA}$$

$$v_x = \frac{10}{8 \cdot 10^{28} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-6}} = 7,8 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$$

d)

A velocidade de deriva é vários ordens de grandeza menor que a velocidade v_F de movimento de elétrons entre 2 colisões. Em outras palavras, o movimento de deriva é muitíssimo mais lento que o movimento aleatório do elétron entre uma colisão e outra.

2)

a) Como a tensão de Hall é negativa, os portadores majoritários são elétrons, logo o semicondutor é do tipo "n".

b)

$$V_H = E_y \cdot w ; E_y = \frac{J_x \cdot B_z}{e \cdot N} \Rightarrow \frac{V}{w} = \frac{i \cdot B_z}{A e N} \Rightarrow \frac{1}{N} = \frac{V_H A e}{w i \cdot B_z} \Rightarrow N = \frac{w \cdot i \cdot B_z}{V_H A e}$$

$$N = \frac{w \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-4}}{100 \cdot 10^{-6} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow N = \frac{10^{-4}}{1,6 \cdot 10^{-27}} = 0,625 \cdot 10^{23} = 6,25 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3} = 6,25 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

c)

$$J_x = e N \mu_n E_x \Rightarrow \mu_n = \frac{J_x}{e N E_x} ; V_{CD} = E_x \cdot L \Rightarrow E_x = \frac{V_{CD}}{L}$$

$$\mu_n = \frac{i_x L}{e A V_{CD} N}$$

$$\mu_n = 0,133 \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{s} \Rightarrow \mu_n = 1333 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s} \rightarrow \text{Silício}$$

d) Cheque a tensão transversal (Y) ao semicondutor que esteja sendo percorrido por uma corrente. Caso exista um campo magnético na direção z, a tensão na direção y será diferente de 0.

3) $N_d \approx n_0 = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

a) $E_F = E_i + k_B T \ln\left(\frac{N_d}{n_i}\right) \Rightarrow E_F - E_i = 26 \cdot 10^{-3} \ln\left(\frac{10^{16}}{10^7}\right) \Rightarrow E_F - E_i = 0,54 \text{ eV}$

b) $p_n = \frac{1}{V_n} = \frac{1}{e \cdot n_0 \cdot \lambda_n} = \frac{1}{10^{-19} \cdot 1,6 \cdot 10^{16} \cdot 8600} = 7,2 \cdot 10^{-4} \text{ A.m}$

c) Degenerado $\rightarrow N_d \approx N_c \quad E_F \approx E_c$

$N_c = 2 \left(\frac{m^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} = 2 \cdot \left(\frac{0,068 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300,29 \text{ K}}{2\pi \cdot (6,62 \cdot 10^{-34})^2} \right)^{3/2} = 4,46 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

4) Índio, família 3A aceitador

a) $p_0 \approx N_a \quad n_0 \approx \frac{n_i^2}{N_a}$

$p_0 = 5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \quad n_0 = \frac{(2,5 \cdot 10^{13})^2}{5 \cdot 10^{16}} = 1,25 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$

b)

$E_F = E_i - k_B T \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right) \Rightarrow E_F - E_i = -26 \cdot 10^{-3} \ln\left(\frac{5 \cdot 10^{16}}{2,5 \cdot 10^{13}}\right) = -0,026 \cdot 7,6 \Rightarrow E_F - E_i \approx -0,2 \text{ eV}$

c)

$N_a \approx n_i \leftarrow$ Inútil

$n_i^2 = p_0^2 = N_c N_v e^{-\frac{E_g}{k_B T}} \Rightarrow \ln\left(\frac{n_i^2}{N_c N_v}\right) = -\frac{E_g}{k_B T} \Rightarrow T = \frac{-E_g \cdot 0,1}{k_B \cdot \ln\left(\frac{n_i^2}{N_c N_v}\right)} = \frac{0,68 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot \ln\left(\frac{(5 \cdot 10^{16})^2}{1,04 \cdot 10^{23} \cdot 4,1 \cdot 10^{23}}\right)}$

$T = 4884 \cdot 0,1 \Rightarrow T = 488,4 \text{ K}$

d)

Não. Como o semicondutor é de tipo p, quanto maior a dopagem mais perto ele fica de E_v , então ele nunca se aproxima de E_c .

$$en_i(\mu_n + \mu_p) = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,5 \cdot 10^{19} (0,39 + 0,19) = 2,32 \text{ A m}^{-1}$$

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{A} = \frac{1}{2,32} \cdot \frac{10^{-2}}{1 \cdot 10^{-6}} = 4,3 \text{ k}\Omega$$

$$b) \quad n_i^2 = N_c N_v e^{\frac{-(E_g)}{k_B T}} \Rightarrow n_i^2 = 1,04 \cdot 10^{19} \cdot 6,1 \cdot 10^{18} e^{\frac{-(0,68) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 400}} \Rightarrow n_i^2 = 3,12 \cdot 10^{29} \Rightarrow$$

$$n_i = 5,6 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$\sigma' = e n_i (\mu_n + \mu_p) = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5,6 \cdot 10^{14} (0,39 + 0,19) \approx 52 \text{ A m}^{-1}$$

$$R = \frac{1}{\sigma'} \cdot \frac{L}{A} \Rightarrow R = \frac{1}{52} \cdot 10^4 = 192 \Omega$$

$$c) \quad R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{A} \Rightarrow R = \frac{10^4}{e \mu_n N} \Rightarrow N = \frac{10^4}{R e \mu_n} = \frac{10^{14}}{10 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,39} = 1,6 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3} = 1,6 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$d) \quad N_d \gg n_i \text{ en } \text{foo} \quad R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{A} = \frac{1}{e \mu_n N} \cdot \frac{L}{A} \Rightarrow R = \frac{1}{1000} \cdot 10^4 = 10 \Omega$$